

会议决定：83年适当时候在安徽省召开第三届《全国集成电路和硅材料学术年会》。

(冯应章)

Second National Conference on Integrated Circuits and Silicon Materials

Guangzhou, 12—17, Dec. 1981

第四届全国砷化镓及有关化合物学术交流会

中国金属学会举办的第四届全国砷化镓及有关化合物学术交流会，于1981年11月25日至28日在上海召开。参加会议代表共139名。会议收到论文及工作报告共117篇。

这次会议的报告内容涉及材料和器件。在材料方面，砷化镓的纯度、完整性和深能级的研究取得可喜的结果，还开展了磷化铟材料的研制，晶体生长和多元固溶体外延也取得进展。在微波及光电器件的研究上达到了一个新水平。

会议期间，还举行了三次座谈会，分别讨论了半导体化合物的科研和今后的发展；原材料及辅助材料；分析及测试等问题，对目前科研和生产中的一些问题，进行了较深入的讨论，加强了相互了解，增进了协作关系。

会议建议第五届会议由中国金属学会和中国电子学会在1983年联合召开。

Fourth National Conference on Gallium Arsenide and Related Compounds

Shanghai, 25—28, Nov. 1981

全国中、大规模集成电路设计及分析学术会议

中国电子学会半导体与集成技术学会委托四机部1424所筹备的全国中、大规模集成电路设计及分析学术会议于1981年11月28日至12月3日在昆明市召开。在云南省科委、电子局领导机关的关心和云南省半导体器件厂的大力支持下，学术会议开得比较成功。

来自全国近80名代表参加了这次会议。会议共收到论文摘要108篇，在会上报告了44篇。通过这次学术会议，可以看到我国中、大规模集成电路的设计、研制、分析测试及计算机辅助设计技术已有了较大的进展，其中双极256位、1024位ROM；MOS 4K静态、16K动态随机存贮器的研制成果，反映了我国中、大规模集成电路的研究设计工作的新水平。但同时应该看到，在这方面还有很多工作要做，如加强CAD软件研制和电路的自行设计能力，进一步发展检测图形技术及工艺模型研究等。

(冯应章)